

METHOD FOR MANUFACTURING SILICON CARBIDE SEMICONDUCTOR DEVICE

Publication number: JP2003086529

Publication date: 2003-03-20

Inventor: NAKAMURA HIROKI; RAJESH KUMAR; OTSUKA YOSHINORI

Applicant: DENSO CORP

Classification:

- International: H01L21/265; H01L21/337; H01L29/808; H01L21/02; H01L29/66; (IPC1-7): H01L21/265; H01L21/337; H01L29/808

- European:

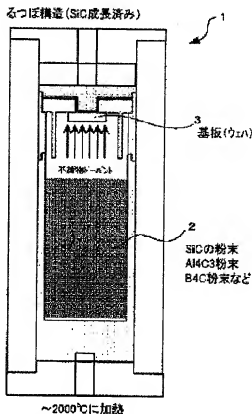
Application number: JP20010276707 20010912

Priority number(s): JP20010276707 20010912

Report a data error here

Abstract of JP2003086529

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a silicon carbide semiconductor device for preventing decrease in surface concentration for improving device characteristics. **SOLUTION:** A feed material 2 made of SiC powder and aluminum carbide that is powder that becomes an impurity dopant is loaded into an induction heating furnace 1 in a crucible structure, and an SiC substrate is mounted to the upper section of the feed material 2 with the side of the feed material 2 being an impurity formed region surface. The SiC substrate 3 patterns a section for forming a p-type impurity region, and performs the ion implantation of He or the like to a required depth for changing into amorphous. The feed material 2 is heated at 2,000 deg.C for subliming the impurity dopant, and made to abut on the Si substrate 3 to diffuse impurities into the amorphous region. Additionally, the SiC substrate 3 also reaches 1,900 deg.C, and impurities are diffused at the amorphous region for recrystallization to form a single crystal. Supplying impurities continuously during heat treatment improves the impurity concentration close to the surface.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	マークシート(参考)		
H 0 1 L	21/265	H 0 1 L	21/265	Z	5 F 1 0 2
	21/337		29/80	C	
	29/808		21/265	Q	

審査請求 未請求 請求項の数17 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2001-276707(P2001-276707)
 (22) 出願日 平成13年9月12日(2001.9.12)

(71) 出願人 000004260
 株式会社デンソー
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
 (72) 発明者 中村 広希
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社
 デンソー内
 (72) 発明者 ラジェッシュ クマール
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
 社デンソー内
 (74) 代理人 100082500
 弁理士 足立 勉

最終頁に続く

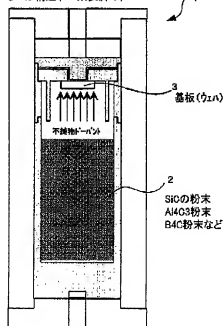
(54) 【発明の名称】 炭化珪素半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】表面濃度の減少を防止しデバイス特性を向上させることができる炭化珪素半導体装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 りつぽ構造の誘導加熱炉1にSiC粉末と不純物ドーパントとなる粉末である炭化アルミニウムとからなる原料2を入れ、その原料2の上に原料2側を不純物領域形成面としてSiC基板3を取り付ける。SiC基板3はp型不純物領域を形成すべき部分をパターンニングし、必要な深さだけHe等をイオン注入してアモルファス化している。原料2を2000℃に加熱して不純物ドーパントを昇華させSiC基板3に当たることによってアモルファス化された領域内に不純物が拡散する。またSiC基板3も1900℃となりアモルファス化された領域では不純物が拡散しながら再結晶化し単結晶となる。熱処理中に継続的に不純物を供給することができるため表面付近の不純物濃度を高めることができる。

るつぽ構造(SiC成長済み)



(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】基板表面をアモルファス化させた炭化珪素半導体 (SiC) 基板とドーパントと SiC 粉末とを一箱に封入して 1800 度以上に加熱する熱処理を行って、気化したドーパントを前記アモルファス化させた SiC 基板に当てることにより当該ドーパントの不純物領域を前記 SiC 基板に形成することを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 2】請求項 1 に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記不純物領域の深さは、アモルファス層の深さで制御することを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 3】請求項 1 または 2 に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記不純物領域の形成位置は、アモルファス領域の形成位置で制御することを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 4】請求項 1～3 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記アモルファス化は、SiC に対して不活性な元素を注入して行うことを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 5】請求項 4 に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記不活性な元素として、He, Ar, Si または C を用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 6】請求項 4 または 5 に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記不活性な元素のドーザ量は $1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2} \sim 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}$ であることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 7】請求項 4～6 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記不活性な元素の注入は室温で行うことを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 8】請求項 4～7 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記不活性な元素に代えてドーパントを用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 9】請求項 1～8 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記ドーパントは粉末またはガスであることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 10】請求項 1～9 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記ドーパントとして炭化アルミニウム (Al_4C_3) を用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 11】請求項 1～10 のいずれかに記載の炭化

2

珪素半導体装置の製造方法において、

前記ドーパントとしてホウ素 (B) または炭化ホウ素 (B_4C) を用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 12】請求項 1～11 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記ドーパントとして、トリメチルアルミニウム (TMAl) または 3 フッカボロン (B_3F_3) を用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

10 【請求項 13】請求項 1～12 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記気化したドーパントは前記 SiC 基板に直接当てるようにすることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 14】請求項 1～13 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記 SiC 基板は、4H、6H または 15R の (0001) 面 (C 面) もしくは (11-20) 面 (a 面) を用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

20 【請求項 15】請求項 1～14 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記加熱は、RF、ヒータ、ランプの少なくともいずれか 1 を用いることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【請求項 16】請求項 1～15 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記ドーパントとなる粉末の温度は、前記 SiC 基板に比べ、 $100^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$ 高くすることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

30 【請求項 17】請求項 1～16 のいずれかに記載の炭化珪素半導体装置の製造方法において、

前記熱処理時の圧力は、 $400 \text{ hPa} \sim 800 \text{ hPa}$ とすることを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】炭化珪素半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

40 【従来の技術】従来より Si 半導体装置においてイオン注入後に熱処理を行うことで不純物領域を形成する方法が知られている。この方法を炭化珪素 (SiC) 半導体装置の不純物領域形成について適用すると、熱処理による不純物の拡散速度が非常に遅く、不純物が拡散しにくいといった問題がある。

【0003】そこで、図 1 (a) に示すように、Ar, C などの不活性な元素を注入して SiC をアモルファス化させ、そのアモルファス化させた領域に B, Al などのドーパントを注入して、熱処理を行うことで、図 1

(b) のように不純物を拡散させる方法が知られている。

(3)

【0004】のようにアモルファス化された領域での不純物の拡散係数は大きく、アモルファス化されていない単結晶領域での不純物の拡散係数は小さいため、アモルファス領域と単結晶領域の境界で不純物の拡散が止まる。またアモルファス化した領域は、活性化熱処理で単結晶化（再結晶化）、欠陥が存在しない不純物領域が形成される。したがって、このような拡散係数の違いによってセパレーションなどを達成することができる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、このようにアルファ化処理した領域にイオン注入により不純物層を形成した後、活性化熱処理によって再結晶化されると、表面の不純物濃度が減少し、図2に示すような不純物のプロファイルとなる。そこで、表面、活性化熱処理によって深さ方向への拡散が起ることから表面付近の不純物が減少する。また活性化熱処理により不純物が基板表面から抜け出てしまう（アウトディフュージョン）ため、表面濃度が減少する。このように表面付近の不純物濃度が減少することにより、表面に電極等を付けた際に、その電極等とのコンタクト抵抗が増加しデバイス特性に影響が出るという問題があった。

【0006】そこで本発明は、表面濃度の減少を防止し、電極等とのコンタクト抵抗を低減して、デバイス特性を向上させることができる炭化珪素半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段及び発明の効果】上述した問題点を解決するためになされた請求項1に記載の炭化素半導体薄膜の製造方法によれば、アモルファス化させた炭化素半導体（SiC）基板へ継続的に不純物を供給しながら活性化熱処理を行うことができ、表面の不純物濃度を高めることができる。したがって、良好なオーミック特性が得られる。活性化熱処理は1800℃以上で行われるため、処理時間が長くなるに比べ、SiC基板中のSiが昇華するSi⁺抜けによる基板の表面荒れが進行する。そのためドープメントとともにSiC粉末を封入して加熱する。このようにすることで平衡状態が保たれSi⁺抜けによる基板の表面荒れを防止することができ、

【0008】こうした熱処理による不純物領域の深さは、請求項2に示すようにアモルファス層の深さで制御することができる。請求項3に示すように選択的に行うことができる。すなわちアモルファス領域は結晶性が崩れているため不純物が拡散し易いが、単結晶領域ではほとんど拡散しない。したがって、S i 基板中で不純物領域を形成したい位置（部分）に比べて必要深さだけアモルファス化することで、容易に設計通りに不純物領域を形成することができる。アモルファス層の深さは例えばアモルファス化するために打ち込むイオンのエネルギー

ルギーを調節すれば容易に制御することができる。またアモルファス領域の形成位置は例えばアモルファス化するためのイオン打ち込み前にアモルファス化する部分以外の部分についてパターンニングを行いITOを形成しておくことで容易に制御することができる。

【0009】こうしたアモルファス化は、請求項4に示すように、Siに対して不活性な元素を注入（打ち込み）して行うという。Siに対して不活性な元素としては、例えば請求項5に示すように、H、He、Ar、S、i、またはCを用いることができる。また不活性な元素のドーズ量は例えば請求項6に示すように $1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2} \sim 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}$ とすればよい。そして、このような不活性な元素の注入は、請求項7に示すように常温で行うという。

【0010】なお請求項4～7においては、S1Cに対して不活性な元素を注入することとしたが、請求項8に示すようにドパントを注入してαモルファム化してもよい。例えばドパントとしてA1等を打込むことができる。請求項1～8において、ドパントは請求項9に示すように、粉末あるいはガスを用いるようにする。すなわち、液体では沸騰する可能性があるため、熱処理温度において揮発する粉末、あるいは、気体（ガス）のいずれかを用いること。粉末に比較して扱いが容易である一方、ガスは制御が容易なので不純物濃度の制御が容易にできる。

【0011】こうしたドーパントとしては、請求項10に示すように炭化アルミニウム (Al_4C_3) や請求項1に示すようにホウ素 (B) または炭化ホウ素 (B 4C)、請求項12に示すようにトリメチルアルミニウム (TMA) または3フッカボロン (BF 3) を用いることにより、p型不純物領域を形成することができる。また、n型不純物領域を形成する場合にも同様にn型のドーパントを使用すればよい。

【0012】そして、請求項1に示すように気化したドーパントをSiC基板に当てる場合に、効率を高めるため、請求項13のようにするとよい。例えば、気化したドーパントの流束方向とSiC基板の処理面の法線方向とが対向するように設置することで気化したドーパントを直接SiC基板に当てることができる。このように直接気化したドーパントを当てることで効率よく不純物領域を形成することができる。

【0013】こうした炭化系半導体装置を製造する際のSiC基板は、例えば請求項14に示すものを用いることができる。また、加熱は例えば請求項15に示すもので行うことができる。こうした加熱を行う際には、請求項16に示すようにドープメントとなる炭素の温度をSiC基板に比べて100℃〜150℃高くするものとする。また熟処理時の圧力は請求項17に示すように400 hPa〜800 hPaの低圧状態で行うものとする。このようにすることで、アモルファス化されたSiC基板内部にド

(4)

5

ーパントを効率的に取り込ませることができ。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、本発明が適用された実施例について図面を用いて説明する。なお、本発明の実施の形態は、下記の実施例に何ら限定されることなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採りうることは言うまでもない。

【0015】本実施例の炭化硅素半導体の製造方法として、図3に高温気相拡散法による製造方法を示す。本実施例の高温気相拡散法は図3に示すように、るつぼ構造の誘導加熱炉1に、SiC粉末と不純物ドーパントとなる粉末とからなる原料2を入れ、その原料2の上方に原料2側を不純物領域を形成する面としてSiC基板3を取り付ける。そして誘導加熱炉1を誘導加熱し、原料2を2000℃に加熱する。

【0016】SiC基板3は、図1(a)に示すように、p型不純物領域を形成すべき部分にLTOを形成し、p型領域の形成が必要な深さだけ、予めアモルファス化している。このアモルファス化は、SiCに対して不活性な元素であるH₂、Ar、SiまたはCを室温でイオン注入して行っている。

【0017】誘導加熱炉1は、原料2を2000℃に加熱した際にSiC基板3の温度が1900℃になるように構成されている。また不純物ドーパントとしては、炭化アルミニウム(A1₄C₃)、ホウ素(B)または炭化ホウ素(B₄C)を用いる。

【0018】誘導加熱炉1を加熱し、原料2を2000℃に加熱することで、原料2の不純物ドーパントは昇華し、昇華ガスとなって図3の矢印の向きに上昇し、SiC基板3に直接当たる。よってSiC基板3のアモルファス化された領域に昇華ガスとなったドーパントが当たり、この領域内に不純物が拡散する。またSiC基板3も1900℃となるためアモルファス化された領域は、不純物が拡散されながら再結晶化されて、完全な単結晶となる。

【0019】この高温気相拡散法では、熱処理中に継続的に不純物を供給することができるため、不純物プロファイルは図4に示すようになり、表面付近の不純物濃度を高めることができる。よって、電極との接触抵抗を低減することが可能となりデバイス特性を向上させることができる。

【0020】なお本実施例では不活性なガスをイオン注入することによってアモルファス化することとしたが、ドーパントを注入してアモルファス化してもよい。注入する元素のドーピング量は $1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ より $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}$ とするとよい。また不純物ドーパントは粉末として説明したが、例えばトリメチルアルミニウム(TMA)または3フッホロン(BF₃)のようなガス(気体)を用いてもよい。そして、熱処理時の圧力は400～800hPaとするとよい。

6

【0021】本実施例では誘導加熱炉1を用いることとしたがヒータ、ランプを用いて加熱する炉としてもよい。次に、このような高温気相拡散法を、トレンチ型JFETのp型ゲートプロセスへの適用例を図5及び図6を参照して説明する。

【0022】図5(a)は、炭化硅素半導体装置としてのトレンチ型JFETの製造工程において、トレンチを形成し、チャンネルエッジ膜を形成した状態を示す図である。図5(a)のSiC基板表面に不純物とならない不活性な元素(Ar, C, Si, Heなど)をイオン注入で打ち込み、表面にアモルファス層を形成する(図5(b)参照)。注入時の温度は常温(RT)である。

【0023】このようにアモルファス層を形成した状態のSiC基板を前述した誘導加熱炉1内に、アモルファス化した表面に昇華したドーパントが直接当たるようにセットして高温気相拡散法による熱処理を行う。アモルファス化された領域(図5(b)のアモルファス層)は、不純物ドーパントが拡散しやすいため、容易にp型不純物層が形成される(図6(c)参照)。

【0024】p型不純物領域の深さはチャンネル部の電子の通り道を確保するため、深さ制御が重要となるが、アモルファス化させる領域は深さは不活性元素の加速エネルギーで制御できるため、容易に制御できる。また、高温気相拡散は1800℃以上の高温の熱処理であるため、アモルファス化された領域は再結晶化され、完全な単結晶に戻る。したがって、欠陥のない、不純物の高活性化率を実現した不純物領域を形成できる。

【0025】高温気相拡散法により、図5(c)の状態となったSiC基板に対して、必要な部分のみ残るようにLTOデポとパターンニングを行いSiCエッチングをした後、LTOを除去することで、図5(d)のようなp型ゲートとチャンネルエッジ膜を得ることができる。この状態から、p型不純物領域に電極となる金属を蒸着するなど、図示しない通常のJFET製造工程を経て、トレンチ型JFETを製造することができる。このように高温気相拡散法により、p型不純物の高活性化を実現した欠陥のないp型不純物領域を形成できるため、pn接合のビルトインポテンシャルV_{bi}が理想のV_{bi}=2.8Vに近づき、チャンネル部の電子の通り道が十分に確保される。また、p型不純物領域の表面の電極との接触抵抗が小さくなり、デバイスのオン抵抗を低減することができる。良好なデバイス特性を得ることができる。

【0026】なお、図5に示したトレンチ型JFETのp型ゲート形成プロセスでは、図5(b)、(c)に示すようにp型不純物領域を基板表面全体に形成した後、図5(d)に示すようにパターンニングを行うこととしたが、図6に示すように、p型不純物領域を形成した部分のみがアモルファス化されるように、LTO層でパターンニングを行い(図6(b)参照)、高温気相拡散法でp型不純物領域を形成した後(図6(c)参照)、チ

(5)

チャネルエド膜のパターンニングを行う(図6(d)参照)プロセスとしてもよい。このようなプロセスを採用した場合も図5に示して説明したプロセスによる効果と同様の効果を得ることができる。

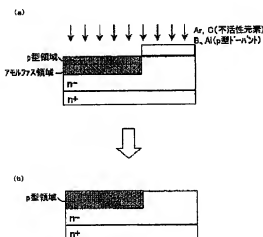
【図面の簡単な説明】

【図1】SiCにおけるアモルファス化と熱処理によるp型不純物領域の形成方法を説明する説明図である。

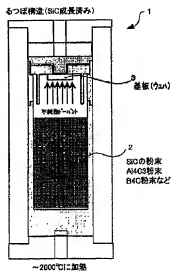
【図2】従来の炭化硅素半導体装置の製造方法による不純物プロファイルを示す図である。

【図3】実施例の炭化硅素半導体装置の製造装置の断面図である。

【図1】



【図3】



8

【図4】実施例の炭化硅素半導体装置の製造方法による不純物プロファイルを示す図である。

【図5】実施例の製造方法をトレンチ型JFETのp型ゲート形成プロセスに適用した場合の例を示す図である。

【図6】図5のトレンチ型JFETのp型ゲート形成プロセスの別例を示す図である。

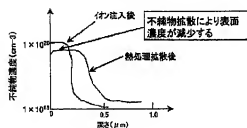
【符号の説明】

1…誘導加熱炉

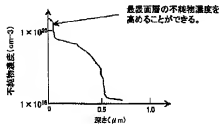
2…原料

3…SiC基板

【図2】

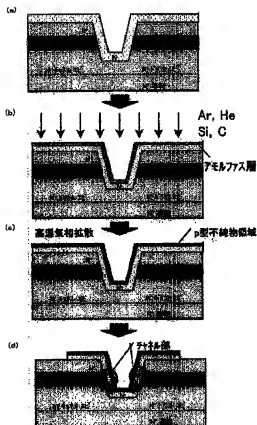


【図4】

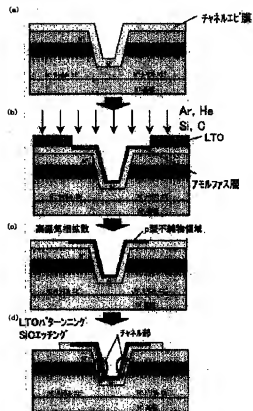


(6)

【図5】



【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 大塚 義則
愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社
社デンソー内

Fターム(参考) 5F102 FA03 GB05 GC08 GC09 GD04
GJ02 GL02 HC00 HC05 HC07
HC21